

# Photoempfänger JI 1P mit Verstärker

- Charakteristik :
- ◆ Spektralbereich 380 ... 1100 nm
  - ◆ strahlungsempfindliche Fläche 1 mm<sup>2</sup>
  - ◆ Si - PIN - Photodiode mit integriertem Strom-Spannungswandler
  - ◆ geringe Dunkeloffsetspannung und Driftparameter
  - ◆ großer Dynamikbereich
  - ◆ Modifikation (Transimpedanz, Zahl der Betriebs-  
spannungen) möglich

- Applikationen :
- ◆ allgemeine lichttechnische und nichtoptische Anwendungen
  - ◆ schneller Detektor zum Nachweis kleiner Strahlungsintensitäten bei hohem Signal/Rausch-  
verhältnis

Grenzwerte:

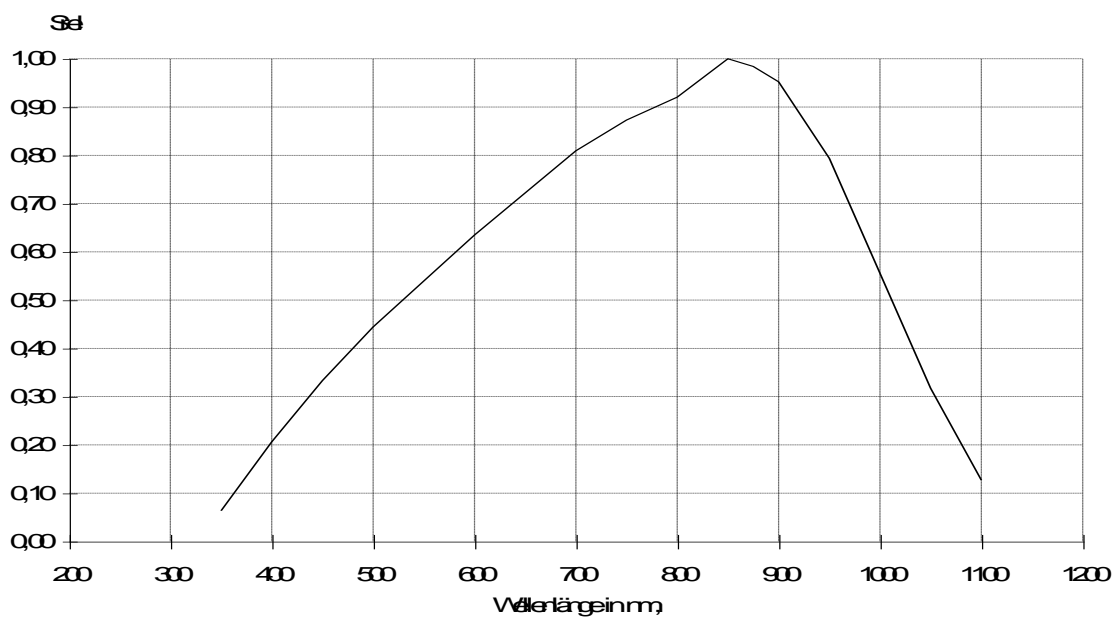
Betriebsspannung	± 18	V
Verlustleistung	180	mW
Betriebstemperaturbereich	- 25 °C ... 70	°C
Lagertemperaturbereich	- 40 °C ... 100	°C
Löttemperatur (3s)	260	°C

Technische Daten :

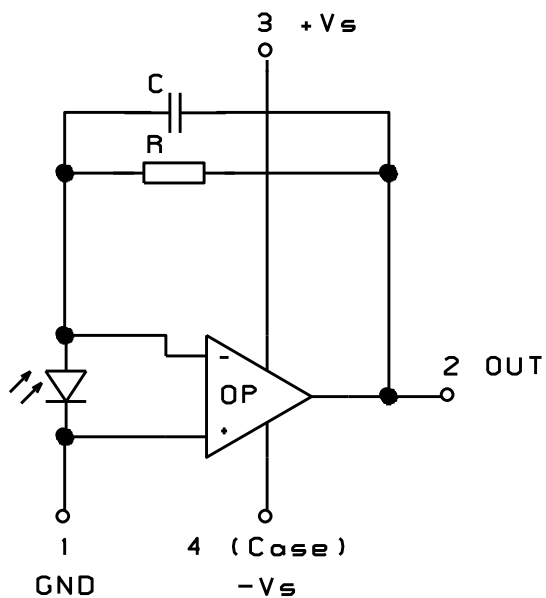
Allgemeine Meßbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert:  $\gamma_a = 23 \text{ °C}$ ,  $V_{cc} = \pm 15 \text{ V}$

Parameter	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einh.
Dunkeloffsetspannung	E = 0 lx		0,5		mV
Aussteuerung			- 13		V
Rauschspannung	B = 20 kHz		0,3	0,5	mV <sub>rms</sub>
Empfindlichkeit	$\lambda = 850 \text{ nm}$		5,5		V/ $\mu$ W
Transimpedanz			10		M $\Omega$
Betriebsspannung		± 5	± 15	± 18	V
Betriebsspannungs- unterdrückung			20		$\mu$ V/V
Stromaufnahme			± 4		mA
Anstiegszeit			8		$\mu$ s
Abfallzeit			8		$\mu$ s
Bandbreite	- 3 dB		40		kHz

## Relative spektrale Empfindlichkeit



## Innenschaltung



## Gehäuseabmessungen

